## Запись во flash память структуры данных

В файле main.h определены следующие структуры данных:

```
typedef struct {
    char secret str[20];
    uint32 t data num;
} data_t;
union FD {
   data t wdata;
   uint32_t wdata32[6];
};
также определены макросы для адресов страниц памяти, в частности
ADDR FLASH PAGE 48 u ADDR FLASH PAGE 127.
      В проекте реализована функция стирания страницы флеш памяти:
void erase_flash()
{
    HAL FLASH Unlock();
    static FLASH_EraseInitTypeDef EraseInitStruct;
   EraseInitStruct.TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
    EraseInitStruct.PageAddress = FLASH USER START ADDR;
    EraseInitStruct.NbPages = 1;
```

if (HAL\_FLASHEx\_Erase(&EraseInitStruct, &PAGEError) != HAL\_OK) {
 printf("ERASING ERROR: page %"PRIu32"\n", PAGEError);

HAL\_FLASH\_Lock();

}

## а также функция записи данных во флеш память:

```
void write_flash(union FD *fd)
    int offset = 0;
    HAL_FLASH_Unlock();
    for (int i = 0; i < sizeof(fd->wdata32) / 4; ++i) {
         HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD,
                             FLASH_USER_START_ADDR + offset, fd->wdata32[i]);
         offset += 4;
    HAL_FLASH_Lock();
}.
       Исходный код основного цикла прошивки:
while (1) {
       if (flash_flag) {
              erase_flash();
              write_flash(&flash_data);
              flash flag = false;
       }
}.
```

## Скриншот дампа записанной памяти.

